

***Книги и статьи, опубликованные сотрудниками предприятия за 2012 год***

1. А.М. Филачев, И.И. Таубкин, М.А. Трищенко **Твердотельная фотозлектроника. Фоторезисторы и фотоприемные устройства.**- М.: Физматкнига, 2012.- 367 с
2. М.В. Седнев, К.О. Болтарь, Ю.С. Мезин, Е.А. Климанов, Ю.П. Шаронов **Исследование факторов, определяющих анизотропность ионно-лучевого травления напыленного слоя индия** // *Прикладная физика*, 2012, №1, с. 90-93
3. А.А. Зайцев, С.С. Хромов **Структура фоточувствительных элементов и ИС считывания для матричных фотоприемных устройств ультрафиолетового диапазона** // *Прикладная физика*, 2012, №1, с. 110-115
4. А.И. Дирочка, А.М. Филачев **Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики** // *Прикладная физика*, 2012, №2, с. 12-17.
5. А.И. Еремчук, А.В. Самвелов, Д.А. Широков **Исследование антифрикционных упрочняющих покрытий для применения в парах трения микрокриогенных систем** // *Прикладная физика*, 2012, №2, с. 93-95
6. Г.А. Аракелов, А.В. Самвелов **Вопросы оптимизации режимов электропитания термоэлектрических охладителей фотоприемников в составе оптико-электронной аппаратуры** // *Прикладная физика*, 2012, №2, с. 96-98
7. К.О. Болтарь, И.Д. Бурлаков, А.М. Филачев, Н.И. Яковлева **Фотоприемное устройство формата 6×576 элементов на спектральный диапазон 8-12 мкм** // *Прикладная физика*, 2012, №3, с. 61-65
8. Н.В. Кардонов, Е.А. Климанов, А.В. Ляликов, Ю.С. Мезин, М.В. Седнев, Б.В. Трошин, Ю.П. Шаронов **Влияние условий напыления на микроструктуру пленок индия** // *Прикладная физика*, 2012, №3, с. 66-69
9. А.В. Никонов, К.О. Болтарь, Н.И. Яковлева **Исследование характеристик спектральной чувствительности фотодиодов на основе гетероэпитаксиальных структур КРТ** // *Прикладная физика*, 2012, №3, с. 70-78
10. Л.И. Горелик, М.Г. Мазин **Анализ возможностей использования отечественных фотообъективов для спектрального диапазона 0,9-1,7 мкм** // *Прикладная физика*, 2012, №3, с. 86-90
11. Л.И. Горелик, В.Н. Соляков, Д.Ю. Тренин, Е.О. Тренина **Измерение температуры двухдиапазонным тепловизионным прибором на основе матричных фотоприемных устройств** // *Прикладная физика*, 2012, №3, с. 95-100
12. Д.С. Андреев, Т.Н. Гришина, Н.Б. Залетаев, М.А. Трищенко **Многоэлементные быстродействующие фотодиоды на основе гетероструктур InGaAs/InP** // *Прикладная физика*, 2012, №4, с. 86-90
13. П.С. Лазарев, М.Г. Мазин, А.В. Сидорин., В.Н. Соляков, Е.О. Тренина, К.А. Хамидуллин, А.Д. Юдовская **Термографический прибор для контроля движущихся объектов** // *Прикладная физика*, 2012, №4, с. 107-110
14. П.В. Горлачук, А.А. Мармалюк, Ю.Л. Рябоштан, В.В. Сарайкин, П.Е. Хакуашев, И.В. Чинарева **Диффузия серы из подложки InP гетероэпитаксиальной структуры InGaAs/InP при изготовлении pin-фотодиодов** // *Прикладная физика*, 2012, №5, с. 77-80
15. И.Д. Бурлаков, А.В. Войцеховский, К.С. Журавлев, С.Н. Несмелов **Детекторы ультрафиолетового диапазона на основе контакта металл-полупроводник из соединения AlGaIn** // *Нано- и микросистемная техника*, 2012 №7, с. 37-47.

16. И.Д. Бурлаков, А.В. Войцеховский, С.Н. Несмелов, Л.Я. Гринченко **Детекторы ультрафиолетового диапазона на основе р-і-n структур из соединения AlGaN** // *Нано- и микросистемная техника, 2012 №6, с. 46-54*
17. Пермикина Е.В., Кашуба А.С., Арбенина В.В. **Дефекты в гетероструктурах на основе Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs(310)** // *Неорганические материалы, 2012, т.48, №7, с. 1-6*
18. E.V. Permikina, A.S. Kashuba, V.V. Arbenina **Defects in Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te based heterostructures grown by Molecular beam Epitaxy on GaAs-Substrates (310)** // *Inorganic Materials, 2012, V.48, N7, pp.665-670*
19. Е.В. Пермикина, А.С. Кашуба, А.В. Ляликов, Е.Д. Коротаев, И.Д. Бурлаков **Исследования гетероэпитаксиальных структур HgCdTe методами микроскопии высокого разрешения** // *Прикладная физика, 2012, №5, с. 81-90*.....
20. А.И. Патрашин, И.Д. Бурлаков, А.А. Лопухин, Н.И. Яковлева **Экспериментальное исследование метода расчета параметров ИК МФПУ** // *Прикладная физика, 2012, №5, с. 91-94*.....
21. П.А. Кузнецов, С.С. Хромов, А.А. Зайцев **Результаты исследования БИС считывания формата 6×576 с аналоговым режимом ВЗН** // *Прикладная физика, 2012, №5, с. 95-97*.....
22. М.Г. Мазин, П.С. Лазарев, Г.Г. Деева, В.Н. Соляков, К.А. Хамидуллин, А.Д. Юдовская **Стенд исследования качества формирователей сигналов изображения на основе многорядных матричных фотоприемных устройств с временной задержкой и накоплением** // *Прикладная физика, 2012, №5, с. 98-102*.....
23. Н.И. Батырев, Е.А. Климанов, В.П. Лисейкин, Д.Р. Надров, М.В. Седнев **Изготовление индиевых микроконтактов с помощью фоторезиста ФПН-20-ИЗО в БИС считывания фотосигнала** // *Прикладная физика, №6, с. 142-144* .....